

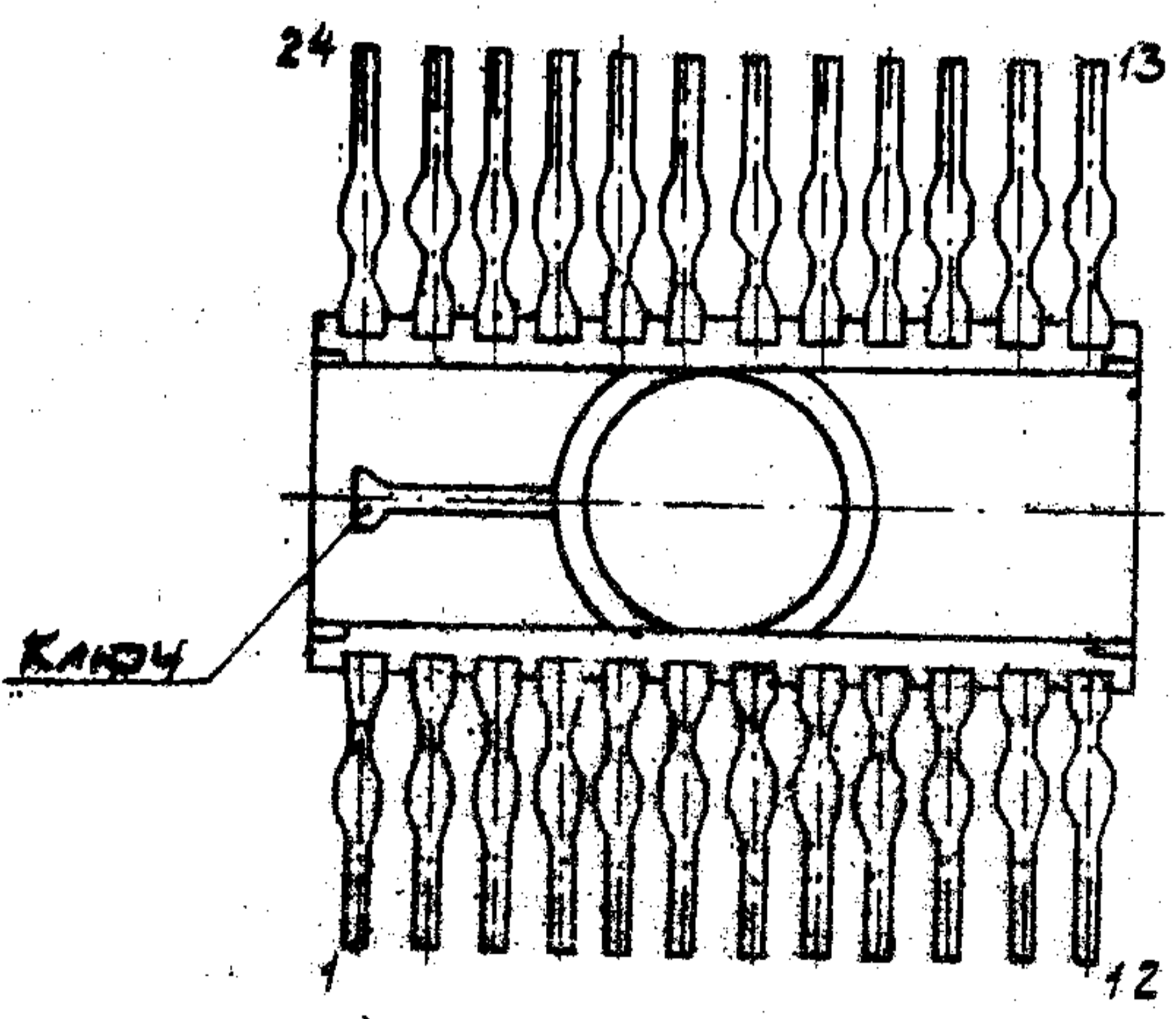


МИКРОСХЕМА ТИПА 507PMI
 СООТВЕТСТВУЕТ
 ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
 0.348.000ТУ

Э Т И К Е Т К А

Функциональное назначение: Матрица-накопитель ОЗУ на 256 бит.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ



Масса не более 3,8 г.

Содержание драгметаллов в 1000 шт. микрохем

Золото
 Серебро

5675106

ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

Кон-такт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Цепь	X ₀	X ₂	X ₄	X ₆	Z ₃	L	Y ₃	Y ₂	Z ₀	Q ₀	P12	U _{CC}	P11	B ₁	Z ₁	Y ₁	Y ₀	U _{CC}	P	Z ₂	X ₇	X ₅	X ₃	X ₁

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t = (+25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквен- ная обозна- чение	Н о р м а	
		не менее	не более
Ток потребления, мА при И.п. = 11 В	$I_{пот}$	-	3
Ток считывания логической "1", мкА при И.п. 9 В	$I_{сч}^1$	42	-
Ток подзарядки, мкА при И.п. = 9 В	I_p	120	-
Ток утечки на входе адресной шины X, мкА при И.п. = 10,5 В	$I_{ут, вхX}$	-	12
Ток утечки на входе адресной шины Y, мкА при И.п. = 10,5 В	$I_{ут, вхY}$	-	12
Ток утечки на входе адресной шины Z, мкА при И.п. = 10,5 В	$I_{ут, вхZ}$	-	12
Ток утечки на входе шины подзарядки Q, мкА при И.п. = 10,5 В	$I_{ут, вхQ}$	-	12
Ток утечки на входе шины подзарядки P, мкА при И.п. = 10,5 В	$I_{ут, вхP}$	-	12
Ток утечки на входе разрядной шины РД, мкА при И.п. = 9 В	$I_{ут, вхРД}$	-	1,0
Амплитуда считывания логической "1" РД1 и РД2, мВ при $\tau_{адр} = 0,3$ мкс в кодах "1-0", "0-1"	$U_{сч, А}^1$	100	-
Амплитуда считывания логической "1" РД1 и РД2, мВ при $\tau_{адр} = 0,3$ мкс в кодах бегущая "1" и бегущий "0"	$U_{сч, А}^1$	100	-
Минимальная длительность импульса записи, И.п. = 10В, нс	$t_{з, min}$	-	150
Высокие по входам адресных шин, разрядным шинам (РД) и шине подзарядки, пФ	C_x	-	14
	C_y	-	14
	C_z	-	9
	C_Q	-	8
	$C_{РД}$	-	8
	C_P	-	27

85

И Т А М И О Т К

И Т А М П Ц З